

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

12.2.2004

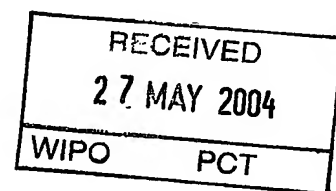
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2003年 6月26日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2003-183605  
[ST. 10/C]: [JP 2003-183605]

出 願 人  
Applicant(s): 独立行政法人 科学技術振興機構



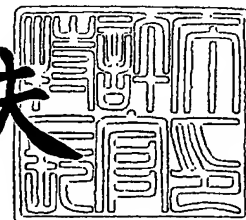
BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 5月14日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 E060P35  
【提出日】 平成15年 6月26日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01B 1/08  
C01F 7/00

## 【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間 2 7 8 6 - 4 - 2 1 2

【氏名】 細野 秀雄

## 【発明者】

【住所又は居所】 東京都世田谷区松原 5 - 5 - 6

【氏名】 平野 正浩

## 【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区新城中町 6 - 2 0 カピトール川  
崎 1 4 0 8 号

【氏名】 林 克郎

## 【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市金沢区並木 1 - 1 1 - 2 - 2 0 1

【氏名】 宮川 仁

## 【発明者】

【住所又は居所】 山梨県甲府市宮前町 7 番地 山梨大学工学部附属クリス  
タル化学研究センター内

【氏名】 山中 功

## 【特許出願人】

【識別番号】 396020800

【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

【代理人】

【識別番号】 100108671

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 義之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 048541

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電気伝導性  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  及び同型化合物とその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ケージ中に含まれるフリー酸素イオンのうち、 $1 \times 10^{18}$ 個/ $\text{cm}^3$ 以上、 $1 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満のフリー酸素イオンを、該酸素イオン1個当り2個の電子で置換した、 $2 \times 10^{18}$ 個以上、 $2 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満の電子をケージ中に含み、室温の電気伝導率が、 $10^{-4}\text{S}/\text{cm}$ 以上、 $10^3\text{S}/\text{cm}$ 未満である事を特徴とする  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

【請求項2】 ケージ中に含まれるフリー酸素イオンのうち、 $1 \times 10^{18}$ 個/ $\text{cm}^3$ 以上、 $1 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満のフリー酸素イオンを、該酸素イオン1個当り2個の電子で置換した、 $2 \times 10^{18}$ 個以上、 $2 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満の電子をケージ中に含み、室温の電気伝導率が、 $10^{-4}\text{S}/\text{cm}$ 以上、 $10^3\text{S}/\text{cm}$ 未満である事を特徴とする  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

【請求項3】 ケージ中に含まれるフリー酸素イオンのうち、 $1 \times 10^{18}$ 個/ $\text{cm}^3$ 以上、 $1 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満のフリー酸素イオンを、該酸素イオン1個当り2個の電子で置換した、 $2 \times 10^{18}$ 個以上、 $2 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満の電子をケージ中に含み、室温の電気伝導率が、 $10^{-4}\text{S}/\text{cm}$ 以上、 $10^3\text{S}/\text{cm}$ 以下である事を特徴とする  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  との混晶化合物。

【請求項4】 ケージ中に含まれるほぼすべてのフリー酸素イオンを、該酸素イオン当り、2個の電子 ( $e^-$  と記述。) で置換した事を特徴とする、実質的に  $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$  と記述されるエレクトライド  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

【請求項5】 ケージ中に含まれるほぼすべてのフリー酸素イオンを、該酸素イオン当り、2個の電子で置換した事を特徴とする、実質的に  $[\text{Sr}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$  と記述されるエレクトライド  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

【請求項6】 ケージ中に含まれるほぼすべてのフリー酸素イオンを、該酸素イオン当り、2個の電子で置換した事を特徴とする、実質的に  $[(\text{Ca}_{1-x}\text{Sr}_x$

)  $24\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4\text{e}^-)$  と記述される  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  との混晶エレクトライド化合物。

【請求項 7】 アルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気中で、 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  単結晶又は該化合物微粉末の静水圧プレス成形体、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  単結晶又は該化合物微粉末の静水圧プレス成形体、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  混晶化合物の単結晶又は該混晶化合物微粉末の静水圧プレス成形体を  $600^\circ\text{C}$  から  $800^\circ\text{C}$  の温度範囲に 4 時間以上 240 時間未満保持して、フリー酸素イオンを電子で置換することを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれかに記載される化合物の製造方法。

【請求項 8】 アルカリ金属として、ナトリウム又はリチウム、アルカリ土類金属として、マグネシウム又はカルシウムを用いる事を特徴とする請求項 7 記載の化合物の製造方法。

【請求項 9】  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物との混晶化合物の微粉末を、一軸プレス、及び／又は静水圧プレスで加圧成形後、カーボン坩堝内に保持し、 $1550^\circ\text{C}$  以上、 $1650^\circ\text{C}$  未満で、1 分以上、2 時間未満保持して、室温まで徐冷し、フリー酸素イオンを電子で置換することを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれかに記載の化合物の製造方法。

【請求項 10】  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物薄膜、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物薄膜、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物との混晶化合物薄膜を、 $500^\circ\text{C}$  以上、 $1400^\circ\text{C}$  以下の温度に保持して、該化合物薄膜に希ガス (Ar, Kr 又は Xe) イオンを打ち込み、フリー酸素イオンを電子で置換することを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれかに記載の化合物の製造方法。

【請求項 11】 請求項 1 から 6 のいずれかに記載された化合物を出発物質として用いる事を特徴とする、 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物との混晶化合物へ、 $\text{O}^-$ 、 $\text{H}^-$ 、又は  $\text{N}^-$  を、 $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$  以上の高濃度かつ高純度に包接させる方法。

【請求項 12】請求項 11 に記載する方法により得られた、N-イオンを  $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$  以上包接することを特徴とする  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  との混晶化合物。

【請求項 13】請求項 1 から 6 のいずれかに記載された化合物を用いる事を特徴とする電子放出材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物（以下 C12A7 と記す。）、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物（以下 S12A7 と記す。）、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  との混晶化合物に高濃度に電子を導入した化合物、これら化合物の製造方法と、これら化合物の用途に関する。

【0002】

【従来の技術】

1970年に H. B. Bartl らは、C12A7 結晶が 2 分子を含む単位胞にある 66 個の酸素のうち 2 個を、結晶中に存在するケージ内の空間に「フリー酸素」として包接しているという、特異な特徴を持つことを示していた（非特許文献 1）。以後、このフリー酸素が種々の陰イオンに置換できることが明らかにされた。

【0003】

本発明者らの一人である細野は、 $\text{CaCO}_3$  と  $\text{Al}_2\text{O}_3$  又は  $\text{Al}(\text{OH})_3$  を原料とし、空气中で  $1200^\circ\text{C}$  の温度で固相反応により合成した C12A7 結晶の電子スピン共鳴を測定することで、 $1 \times 10^{19}$  個  $\text{cm}^{-3}$  程度の  $\text{O}_2^-$  が包接されていることを発見し、フリー酸素の一部が  $\text{O}_2^-$  の形でケージ内に存在するというモデルを提案した（非特許文献 2）。

【0004】

本発明者らは、カルシウムとアルミニウムを概略 12:14 の原子当量比で混合した原料を、雰囲気と温度を制御した条件下で固相反応させ、 $10^{20}$  個  $\text{cm}^{-3}$  以上の高濃度の活性酸素種を包接する C12A7 化合物が得られることを新たに見出した。そ

の化合物自体、その製法、包接イオンの取り出し手段、活性酸素イオンラジカル  
の同定法、及び該化合物の用途に関する発明について、特許出願した（特許文献  
1）。

#### 【0005】

また、該化合物中の $\text{OH}^-$ イオンなど酸素以外のアニオン濃度を制御し、 $700^\circ\text{C}$ 付  
近で、活性酸素を包接させたり、取り出したりする方法を新たに見出し、これに  
関する発明を特許出願した（特許文献2）。さらに、活性酸素を高濃度に含むC1  
2A7化合物に電場を印加することで、高密度の $\text{O}^-$ イオンビームを取り出せること  
を見出し、これに関する発明を特許出願した（特許文献3）。

#### 【0006】

また、水中、水分を含む溶媒中、又は水蒸気を含む気体中で水和反応させたC1  
2A7化合物粉末を、酸素雰囲気中で焼成することにより、 $\text{OH}^-$ イオンを $10^{21}$ 個 $\text{cm}^{-3}$ 以  
上の濃度で含むC12A7化合物を合成し、その化合物自体、その製法、 $\text{OH}^-$ イオンの  
同定法、及び該化合物の応用に関する発明について、特許出願した（特許文献4  
）。

#### 【0007】

また、水素陰イオンを含むC12A7化合物が高速イオン伝導を示す物質であるこ  
と、電場の印加によりその水素陰イオンを真空中に引き出せることを見出した。  
さらには、紫外線又はX線照射により緑色の着色が生じること、同時に電氣的絶  
縁体から電気伝導体に永続的に変化し、加熱又は強い可視光の照射により再び絶  
縁状態に戻せることも発見し、これの応用に関する発明について特許出願した（  
特許文献5）。

#### 【0008】

また、C12A7化合物と同等の結晶構造を持つ化合物として、S12A7化合物が知ら  
れている（非特許文献3）。本発明者らは、S12A7についてもその合成方法と活  
性酸素イオンの包接方法、該化合物の応用に関する発明を特許出願した（特許文  
献6）。

#### 【0009】

さらに、C12A7、S12A7、及びそれらの混晶化合物にアルカリ金属ないしイオン

を包接させ、 $10^{-6} \text{ S/cm}^3$ 以上の電気伝導性が得られることを発見し、特許出願した（特許文献 7）

### 【0010】

エレクトライド(Electride)化合物は、J.L.Dyeがはじめて提案した概念（非特許文献 4）で、クラウンエーテルを陽イオンとし、電子を陰イオンとした化合物などではじめて実現した。エレクトライドは、陰イオンとして含まれる電子のホッピングにより電気伝導性を示す事が知られている。その後いくつかの有機化合物エレクトライドが見出されたが、これらの化合物は、いずれも、 $100^\circ \text{ K}$  程度以下の低温でのみ安定であり、空気や水と反応する著しく不安定な化合物である。

### 【0011】

最近、シリカを骨格とするゼオライト化合物粉末に、セシウムをドーピングすることで無機エレクトライド化合物が見出された。シリカゼオライトにクラウンエーテルのような錯形成の役割を演じさせ、室温安定化を狙ったものである。しかしながら、この化合物も、水分との反応性が高く、化学的に不安定である（非特許文献 5）。また、エレクトライド化合物の優れた電子放出特性を用いたダイオードが提案されている（特許文献 8）が、これまで得られたエレクトライド化合物が温度及び化学的に不安定なため、提案された真空ダイオードは低温でしか作動しない。

### 【0012】

#### 【特許文献 1】

特願2001-49524(特開2002-3218号公報)

#### 【特許文献 2】

特願2001-226843(特開2003-40697号公報)

#### 【特許文献 3】

特願2001-377293

#### 【特許文献 4】

特願2001-117546(特開2002-316867号公報)

#### 【特許文献 5】



特願2002-117314

【特許文献6】

特願2002-045302

【特許文献7】

特願2002-188561

【特許文献8】

米国特許第5,675,972号明細書・図面

【非特許文献1】

H.B.Bartl and T.Scheller, Neues Jahrb. Mineral, Monatsh. 1970, 547

【非特許文献2】

H.Hosono and Y.Abe, Inorg. Chem. 26, 1193, 1987, 「材料科学」, 第33巻, 第4号, p171-172, 1996

【非特許文献3】

O.Yamaguchi et al., J. Am. Ceram. Soc. 69[2]C-36, 1986)

【非特許文献4】

F.J.Tehan, B.L.Barrett, J.L.Dye, J. Am. Chem. Soc., 96, 7203-7208 (1974)

【非特許文献5】

A.S.Ichimura, J.L.Dye, M.A.Camblor, L.A.Villaescusa, J. Am. Chem. Soc, 124, 1170, (2002))

【0013】

【発明が解決しようとする課題】

これまで、CaO、又はSrOとAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の固溶系において、室温で高い電気伝導性 ( $>10^{-4}\text{Scm}^{-1}$ ) を有する物質を得ることは困難であった。また、上に述べた水素陰イオンを包接したC12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物では、永続的な電気伝導性を実現するためには、紫外線照射の処理が必要であり、高温にすると、電気伝導率が低下するなどの問題があった。

【0014】

また、アルカリ金属を包接して、電気伝導性を発現する方法は、アルカリ金属ないしイオンを、化合物内部まで、大量に包接させる事が難しく、高い伝導度が

得にくいという問題点があった。すなわち、水素イオン及びアルカリ金属イオン包接による方法では、C12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物に含まれるフリー酸素イオンを、高濃度、あるいはフリー酸素イオンのすべてを電子で置換する事はできなかった。

#### 【0015】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、水素陰イオン及びアルカリ金属イオンを包接したC12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物に関する研究から得られた知見を基に研究を重ねた結果、高温のアルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気中に保持されたC12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物の単結晶又は該化合物微粉末の静水圧プレス成形体が、紫外線照射を行わないにも関わらず、黒緑色の着色を生じていること、また同時に、 $1\text{ S/cm}$ 以上の高い電気伝導性を有していることを発見した。

#### 【0016】

該化合物の光吸収スペクトル、電子スペクトル及びX線回折スペクトルなどを解析して、C12A7、S12A7、又はそれら混晶化合物中のほとんどのフリー酸素イオンが引き抜かれ、引きぬかれた各酸素イオン当り2個の電子を該化合物中に残留させている事を見出した。

#### 【0017】

C12A7化合物、又は、S12A7化合物中に含まれるフリー酸素をすべて電子( $e^-$ と記述。)で置換した場合は、該化合物は、 $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}(4e^-)$ 又は、 $[\text{Sr}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}(4e^-)$ と記述される。該化合物は、 $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}$ 又は、 $[\text{Sr}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}$ を陽イオン、電子を陰イオンとしたエレクトライド化合物とみなす事ができる。

#### 【0018】

また、C12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物微粉末を静水圧プレスで成形し、カーボン坩堝中で、 $1600^\circ\text{C}$ 程度に保持し、徐冷する事によっても、ほとんど全てのフリー酸素を電子で置換できることを発見した。さらに、 $500^\circ\text{C}$ 以上、 $1400^\circ\text{C}$ 以下の温度、最も好ましくは、 $600^\circ\text{C}$ に保持したC12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物薄膜に希ガスイオンを打ち込む事によっても、多

くのフリー酸素を電子で置換できることを発見した。

#### 【0019】

本発明は、安定な固体材料であるC12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物をアルカリ金属蒸気又はアルカリ土類金属蒸気中に高温に保持する処理、カーボン坩堝中に高温に保持して、徐冷する処理、又は昇温した該化合物薄膜への希ガスイオン打ち込みにより、本来は電気的絶縁体であるC12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物を電気伝導体に永続的に変化させる方法を提供する。

#### 【0020】

特に、高温でのアルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気処理法、又は、カーボン坩堝中での高温保持及び徐冷処理法では、ほぼ完全にフリー酸素を引き抜き、電子で置換することができ、熱的、化学的に安定な無機固体エレクトライド化合物を製造することができる。安定な固体エレクトライド化合物は、室温で動作する電子放出材として利用できる。また、一般的に、電子は、強い還元作用を有するので、これらのエレクトライド化合物粉末は還元剤として応用することができる。

#### 【0021】

さらに、本発明は、該エレクトライド化合物を、酸素、水素、又は窒素雰囲気中で熱処理して、電子を陰イオンで置換し、C12A7、S12A7、又はそれらの混晶化合物に、O<sup>-</sup>、H<sup>-</sup>又はN<sup>-</sup>を選択的かつ大量に包接させる方法を提供する。

#### 【0022】

すなわち、本発明は、下記のものからなる。

(1) ケージ中に含まれるフリー酸素イオンのうち、 $1 \times 10^{18}$ 個/cm<sup>3</sup>以上、 $1.1 \times 10^{21}$ 個/cm<sup>3</sup>未満のフリー酸素イオンを、該酸素イオン1個当り2個の電子で置換した、 $2 \times 10^{18}$ 個以上、 $2.2 \times 10^{21}$ 個/cm<sup>3</sup>未満の電子をケージ中に含み、室温の電気伝導率が、 $10^{-4}$ S/cm以上、 $10^3$ S/cm未満である事を特徴とする $12CaO \cdot 7Al_2O_3$ 化合物。

(2) ケージ中に含まれるフリー酸素イオンのうち、 $1 \times 10^{18}$ 個/cm<sup>3</sup>以上、 $1.1 \times 10^{21}$ 個/cm<sup>3</sup>未満のフリー酸素イオンを、該酸素イオン1個当り2個の電子で置換した、 $2 \times 10^{18}$ 個以上、 $2.2 \times 10^{21}$ 個/cm<sup>3</sup>未満の電

子をケージ中に含み、室温の電気伝導率が、 $10^{-4}\text{S}/\text{cm}$ 以上、 $10^3\text{S}/\text{cm}$ 未満である事を特徴とする  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

(3) ケージ中に含まれるフリー酸素イオンのうち、 $1 \times 10^{18}$ 個/ $\text{cm}^3$ 以上、 $1.1 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満のフリー酸素イオンを、該酸素イオン1個当り2個の電子で置換した、 $2 \times 10^{18}$ 個以上、 $2.2 \times 10^{21}$ 個/ $\text{cm}^3$ 未満の電子をケージ中に含み、室温の電気伝導率が、 $10^{-4}\text{S}/\text{cm}$ 以上、 $10^3\text{S}/\text{cm}$ 以下である事を特徴とする  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  との混晶化合物。

#### 【0023】

(4) ケージ中に含まれるほぼすべてのフリー酸素イオンを、該酸素イオン当り、2個の電子 ( $e^-$ と記述。) で置換した事を特徴とする、実質的に  $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$  と記述されるエレクトライド  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

(5) ケージ中に含まれるほぼすべてのフリー酸素イオンを、該酸素イオン当り、2個の電子で置換した事を特徴とする、実質的に  $[\text{Sr}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$  と記述されるエレクトライド  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物。

(6) ケージ中に含まれるほぼすべてのフリー酸素イオンを、該酸素イオン当り、2個の電子で置換した事を特徴とする、実質的に  $[(\text{Ca}_{1-x}\text{Sr}_x)_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$  と記述される  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  との混晶エレクトライド化合物。

#### 【0024】

(7) アルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気中で、 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  単結晶又は該化合物微粉末の静水圧プレス成形体、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  単結晶又は該化合物微粉末の静水圧プレス成形体、又は  $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  化合物と  $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$  混晶化合物の単結晶又は該混晶化合物微粉末の静水圧プレス成形体を  $600^\circ\text{C}$  から  $800^\circ\text{C}$  の温度範囲に4時間以上240時間未満保持して、フリー酸素イオンを電子で置換することを特徴とする上記(1)から(6)のいずれかの化合物の製造方法。

(8) アルカリ金属として、ナトリウム又はリチウム、アルカリ土類金属として

、マグネシウム又はカルシウムを用いる事の特徴とする上記（7）の化合物の製造方法。

【0025】

（9） $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、又は $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物と $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物との混晶化合物の微粉末を、一軸プレス、及び／又は静水圧プレスで加圧成形後、カーボン坩堝に保持して、 $1550^\circ\text{C}$ 以上、 $1650^\circ\text{C}$ 未満で、1分以上、2時間未満保持し、室温まで徐冷し、フリー酸素イオンを電子で置換することを特徴とする上記（1）から（6）のいずれかの化合物の製造方法。

【0026】

（10） $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物薄膜、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物薄膜、又は $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物と $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物との混晶化合物薄膜を、 $500^\circ\text{C}$ 以上、 $1400^\circ\text{C}$ 以下の温度に保持して、該化合物薄膜に希ガス（Ar, Kr又はXe）イオンを打ち込み、フリー酸素イオンを電子で置換することを特徴とする上記（1）から（3）のいずれかの化合物の製造方法。

【0027】

（11）上記（1）から（6）のいずれかの化合物を出発物質として用いる事の特徴とする、 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、又は $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物と $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物との混晶化合物へ、 $\text{O}^-$ 、 $\text{H}^-$ 、又は $\text{N}^-$ を、 $1 \times 10^{18}/\text{cm}^3$ 以上の高濃度かつ高純度に包接させる方法。

（12）上記（11）の方法により得られた、 $\text{N}^-$ イオンを $1 \times 10^{18}/\text{cm}^3$ 以上包接することを特徴とする $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、 $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、又は $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物と $12\text{SrO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ との混晶化合物。

【0028】

（13）上記（1）から（6）のいずれかの化合物を用いる事の特徴とする電子放出材料。

【0029】

**【発明の実施の形態】**

本発明において出発物質とされるものは、純粋なC12A7化合物でもよいし、処理中にC12A7特有の結晶構造が破壊されない限りは、カルシウムとアルミニウムの一部又はカルシウム又はアルミニウムの全てが他の元素で置換されたC12A7化合物と同等の結晶構造をもつ混晶や固溶体（以下、これらを同型化合物と略称する）でもよい。

**【0030】**

C12A7化合物と同型の結晶構造をもつ化合物として現在S12A7が知られており、CaとSrの混合比を自由に変化させることができる。つまり、C12A7とS12A7の混晶化合物でもよい。また、出発物質に最初から包接されている陰イオンの種類や量は、フリー酸素の引き抜き及び電子との置換効果に大きな影響を及ぼさない。さらに、出発物質の形態は、粉末、膜、多結晶体、単結晶のいずれでもよい。

**【0031】**

出発物質であるC12A7は、カルシウムとアルミニウムを原子当量比で12:14含む原料を用い、焼成温度1200℃以上、1415℃未満で固相反応させることで合成される。代表的な原料は炭酸カルシウムと酸化アルミニウムである。

**【0032】**

単結晶は、固相反応で得られたC12A7を前駆体として、帯融法（FZ法）によって得ることができる。C12A7単結晶の育成には、棒状のセラミック前駆体に赤外線を集光しながら前駆体棒を引き上げることにより溶融帯を移動させて、溶融帯—凝固部界面に単結晶を連続的に成長させる。本発明者らは、高濃度の活性酸素種を含むC12A7化合物単結晶と、気泡の無いC12A7単結晶の製造方法に関する発明について特許出願している（特許文献2；特願2001-226843号、特開2003-40697号公報）。

**【0033】**

出発物質のC12A7化合物又は同型化合物の単結晶を、アルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気を含む雰囲気中、600℃以上、800℃未満の温度、望ましくは700℃の温度に、4時間から240時間保持した後、300℃/時間程度の降温度度で室温まで冷却する。アルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気を含む

雰囲気は、石英ガラスのような熱的、化学的耐久性のある容器中にアルカリ金属片や粉末又はアルカリ土類金属片や粉末と出発物質を真空封入するとよい。

#### 【0034】

アルカリ金属は、C12A7化合物及び同型化合物の単結晶中に包接されることもあるので、フリー酸素を引き抜く目的のためには、包接される事の少ないアルカリ土類金属蒸気を用いる事が望ましく、出発原料がC12A7化合物の場合は、出発原料中に含まれるカルシウム金属蒸気が最も望ましい。アルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気は、単結晶の表面に堆積し、単結晶内部に包接されているフリー酸素と反応して、例えば、カルシウムを用いた場合は、表面に酸化カルシウム層を形成する。単結晶を保持する温度が600℃未満、特に500℃以下では、フリー酸素の引き抜き反応が著しく遅く、800℃以上では、フリー酸素の引き抜きが急速に進み、C12A7化合物及び同型化合物が分解してしまう。

#### 【0035】

保持時間の長さと共に、引き抜かれるフリー酸素量が増加し、表面の酸化カルシウム層が厚くなる。700℃で、240時間保持するとほぼ全量のフリー酸素が引き抜かれ、電子と置き換わり、酸化カルシウム層の内側にエレクトライドC12A7化合物が形成される。引き抜かれたフリー酸素量は、X線回折スペクトル、酸化カルシウム層の厚さ、0.4 eVにピークを持つ光吸収バンド強度、電気伝導度から求める事ができる。

#### 【0036】

出発物質のC12A7化合物及び同型化合物の微粉末を一軸プレスで成形した後、更に、静水圧プレスで追加成形する。静水圧プレスができる様に出発物質が成形されていれば、最初の一軸プレスを省略してもよい。一軸プレスの成形圧は、約200 kg/cm<sup>2</sup>以上、約400 kg/cm<sup>2</sup>以下、好ましくは、300 kg/cm<sup>2</sup>程度とし、静水圧プレスの成形圧は、2000 kg/cm<sup>2</sup>程度が好ましい。

#### 【0037】

得られた成形体を蓋付きのカーボン坩堝中に入れ、該坩堝を蓋付きアルミナ坩堝中に設置し、1550℃以上、1650℃未満、好ましくは約1600℃に昇

温して、該温度に1分以上、2時間未満、好ましくは1時間保持した後、冷却する。保持温度が上記の範囲より高温では、単相のC12A7化合物及び同型化合物を生成する事ができない。また、保持温度が1550°C未満では、単相のC12A7化合物及び同型化合物を生成する事はできるが、フリー酸素と電子の置換が起こらない。また、保持時間が、1分未満では、 $1 \times 10^{18}$ 個/cm<sup>3</sup>未満のフリー酸素しか電子と置換しない。また、2時間以内にほぼ全量のフリー酸素と電子の置換が完了するので、2時間以上保持する必要はない。

#### 【0038】

粉末をこのような圧力で加圧成形することにより、フリー酸素引き抜き反応の速度が緩和されると考えられ、フリー酸素引き抜き後もC12A7化合物が得られる。加圧成形せずに微粉末の状態でフリー酸素引き抜き反応を行うと、生成物は、3CaO·Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相(C3A)又はCaO·Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相(CA)に分解してしまい、これらの相にはケージが存在しないので、電子を包接することができない。

#### 【0039】

昇温速度は400°C/時間程度とする。降温速度は400°C/時間程度で、室温まで冷却する。昇温速度は、生成物に大きな影響を与えず、通常の電気炉では400°C/時間程度が得やすい。昇温速度を500°C/時間以上に著しく早くするためには、大容量の電気炉が必要となる。降温速度が500°C/時間以上と著しく大きいと得られた化合物がガラス状となり結晶化しにくい。

#### 【0040】

カーボン坩堝を直接電気炉中に設置しても生成物は得られるが、電気炉のヒーターからの汚染を防ぐため、さらに、カーボン坩堝の大気との反応を緩和するために、カーボン坩堝を、アルミナ坩堝中に設置した方がよい。得られた化合物は、黒色(粉末は緑色)で、X線回折によりC12A7相であることが分かる。また、約10S/cmの電気伝導度を示し、フリー酸素イオンが電子で置換されている事が確認できる。

#### 【0041】

C12A7化合物同型化合物の多結晶薄膜は、該化合物の焼結体をターゲットとして、MgO基板上に、パルスレーザー堆積法により、アモルファス膜を形成した後



、大気中で約 1100℃ に保持する事により得られる。

#### 【0042】

MgO 基板上に堆積した C12A7 化合物又は同型化合物の多結晶薄膜を、600℃ に保持し、360 kV 程度に加速した Ar イオンを該薄膜に打ち込んだ。イオン打ち込み前の薄膜は、電気絶縁性を示す。ドーズ量が  $5 \times 10^{17} / \text{cm}^2$  に対して、約  $1 \text{ S} / \text{cm}$  の電気伝導性が得られる。ラザフォード後方散乱スペクトルから、Ar イオンは膜中に含まれていないことが確認される。したがって、Ar イオンがフリー酸素イオンに衝突し、ノックオン効果により、フリー酸素イオンが膜外にはじき出され、電気的中性を保つために、電子が膜中に残ったと考えられる。

#### 【0043】

フリー酸素が引き抜かれたエレクトライド C12A7 化合物では、電気的中性を保つために、酸素イオン 1 個当り、2 個の電子が化合物中に残される。こうしたフリー酸素と置換した電子は、ケージ中に緩く束縛されており、ケージ間をホッピングして移動する事ができる。フリー酸素量は、化合物中に  $1.1 \times 10^{21} \text{ 個} / \text{cm}^3$  程度含まれているので、その全量を電子で置換した場合、電子濃度は、 $2.2 \times 10^{21} \text{ 個} / \text{cm}^3$  となる。室温での電子の移動度は約  $0.1 \text{ cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{秒})$  であるので、電気抵抗は、約  $100 \text{ S} / \text{cm}$  となる。また、ケージ中に緩く束縛された電子により、0.4 eV 及び 2.8 eV にピークを持つ 2 つの光吸収バンドが生じる。このために、電子の包接量の増加と共に、C12A7 化合物は、黄色、緑、黒緑色に着色する。また、これらの吸収バンドの強度から、包接されている電子量を求める事ができる。

#### 【0044】

C12A7 化合物及び同型化合物中に含まれる電子は、ケージ内に緩く束縛されているので、室温で、外部から高電場を印加する事により、外部に取り出す事ができる。すなわち、電子を大量に含む C12A7 化合物及び同型化合物は、電子放出材料として使用する事ができる。電子放出は広い温度範囲で起こり、室温でも  $10 \mu\text{A}$  程度の電流が得られる。

#### 【0045】

ほとんど全てのフリー酸素イオンを電子で置換した C12A7 化合物及び同型化合

物では、ケージ中に、電子のみが包接されており、陰イオンは、ほとんど包接されていない。該C12A7化合物又は同型化合物を、純粋な特定の気体分子、イオン又はラジカル雰囲気中で、高温に保持すると、該分子、イオン又はラジカルが、C12A7化合物又は同型化合物内にとり込まれ、電子と結合して、一価のアニオンとして、ケージ内に包接される。

#### 【0046】

すなわち、上記雰囲気中にエレクトライドC12A7又は同型化合物を保持することにより、特定の二価アニオンを高濃度かつ選択的に包接するC12A7化合物又は同型化合物を作製する事ができる。特定の気体分子としては、酸素、水素及び窒素が可能で、その結果、O<sup>2-</sup>、H<sup>-</sup>又は、N<sup>-</sup>イオンを大量かつ選択的に包接するC12A7化合物又は同型化合物を作製する事ができる。

#### 【0047】

O<sup>-</sup>イオンを包接するC12A7化合物及び同型化合物は、酸化触媒及びO<sup>-</sup>ビーム発生材料などとして応用することができる（特許文献1参照）。H<sup>-</sup>イオンを包接するC12A7化合物及び同型化合物は、紫外線照射により電導パターンの形成、H<sup>-</sup>ビーム発生材料などとして応用することができる（特許文献5参照）。また、N<sup>-</sup>イオンを包接するC12A7化合物及び同型化合物は、窒化触媒としての応用が期待される。

#### 【0048】

##### 【実施例】

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

##### 実施例1

帯融法（FZ法）によって作製したC12A7単結晶を0.4mm×4mm×7mmの薄板に加工し、両面を鏡面研磨した（試料1とする。）。該単結晶薄板とカルシウム金属片を、石英管中に入れ、真空封入した。5個の該試料を、700℃で、それぞれ4時間、12時間、18時間、40時間及び240時間保持した（保持時間の異なる結晶薄板をそれぞれ、試料2、3、4、5、及び6とする。）。保持時間が長くなるにつれて、C12A7単結晶薄板は、黄色、緑から黒へと着色したが、表面層は透明であり、該表面層は、X線回折スペクトルから、酸化カルシ

ウムである事が確認された。酸化カルシウム層を除去した結晶薄板は、X線回折パターンから、C12A7の結晶構造を維持していることが分かった。

#### 【0049】

しかし、240時間保持した試料6では、X線回折ピークの相対強度から、フリー酸素が引き抜かれている事が分かった。図1に、試料1～4の光吸収スペクトルを示す。700℃での保持時間の増加と共に、2.8 eVにピークを持つ光吸収バンドの強度が増加している。この吸収バンドは、ケージ内に束縛された電子によるものであり、吸収強度の増加は、保持時間の増加と共に、電子濃度が増加していることを示している。

#### 【0050】

図2は、試料5、6の拡散反射スペクトルからクベルカームンク法により求めた光吸収スペクトルを示す。2.8 eVにピークを持つ光吸収バンドが増大しており、ケージ中に包接された電子濃度がさらに増加していることがわかる。

#### 【0051】

図3は、試料1～6の電気伝導の温度変化を示したものである。保持時間の増加と共に、室温での電気伝導率が増加しており、ケージ中に包接された電子の濃度が増加していることがわかる。光拡散反射及び電気伝導度から、試料6では、包接される電子の数は、 $2 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ であり、これは、ほぼ全てのフリー酸素イオンが電子で置換された事を示している。すなわち、カルシウム金属蒸気中に、700℃、240時間保持する事により、 $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$ と記述されるエレクトライドC12A7化合物を作成することができた。

#### 【0052】

##### 実施例2

C12A7化合物微粉末を、 $300 \text{ kg} / \text{cm}^2$ の一軸加圧で成形後、さらに、 $2000 \text{ kg} / \text{cm}^2$ の静水圧プレスにより、追加成形した。2個の該成形体を、それぞれ蓋付きカーボン坩堝に入れ、さらに、蓋付きアルミナ坩堝に入れ、400℃/時間の昇温速度で、一方を1550℃まで、他方を1600℃まで昇温させた後、1時間保持し、400℃/時間の降温速度で室温まで冷却した。

#### 【0053】

得られた固形物は、緻密で、黒緑色を呈しており、1600℃に保持した固形物は、1550℃に保持した固形物よりも、より黒色度が大きかった。1550℃及び1600℃に保持した固形物の電気伝導率は、それぞれ約5 S/cm及び約10 S/cmであった。X線回折パターンから、両固形物ともC12A7化合物単相であり、固形物の上下方向は、 $\langle 111 \rangle$ 方向に強く配向していた。

#### 【0054】

以上のことから、加圧成形したC12A7微粉末を、カーボン坩堝中で、1550℃又は1600℃で熱処理する事により、C12A7中のフリー酸素を電子で置換する事ができた。特に、1600℃に保持した場合は、ほぼ全てのフリー酸素を電子で置換でき、 $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$ と記述されるエレクトライドC12A7化合物を作成することができた。

#### 【0055】

##### 比較例 1

C12A7粉末を3個の試料として、それぞれ蓋付きカーボン坩堝に入れ、さらに、蓋付きアルミナ坩堝に入れ、400℃/時間の昇温速度で、それぞれ1480℃、1550℃、及び1600℃まで昇温させた後、一時間保持し、400℃/時間の降温速度で室温まで冷却した。1480℃に保持した試料は、透明なC12A7で、電気絶縁体であり、フリー酸素と電子の置換は起こらなかった。1550℃及び1600℃に保持した試料は、C3A相とCA相に分解し、C12A7相は得られなかった。

#### 【0056】

以上のことから、微粉末を静水圧プレス加圧成形するプロセスを省略し、 $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+} (4e^-)$ と記述されるエレクトライドC12A7化合物を粉末原料から直接作成することは試料を1600℃に保持してもできないことが分かった。

#### 【0057】

##### 実施例 3

MgO基板上に堆積したC12A7化合物薄膜を、600℃の温度に保持し、360 kV程度に加速したArイオンを、該薄膜に打ち込んだ。イオン打ち込み前の薄膜は

、電気絶縁性を示したが、Arイオン打ち込みドーズ量が $5 \times 10^{17} / \text{cm}^2$ のとき、約 $1 \text{ S} / \text{cm}$ の電気伝導性が得られた。ラザフォード後方散乱スペクトルから、Arイオンは膜中に含まれていないことが確認された。

#### 【0058】

したがって、Arイオンがフリー酸素イオンに衝突し、ノックオン効果により、フリー酸素イオンが膜外にはじき出され、電気的中性を保つために、電子が膜中に残ったと考えられる。すなわち、高温状態のC12A7薄膜に、Arイオンを打ち込む事により、フリー酸素を電子で置換して、電気伝導性を発現する事ができた。

#### 【0059】

##### 実施例 4

実施例 1 により作成したエレクトライドC12A7化合物（試料 6）の裏面に白金電極を形成し、もう一方の表面に、表面から $0.05 \text{ mm}$ 離れた位置に銅電極を設置し、銅電極をプラス極として、室温で、両電極間に、加速電圧を印加した。図 4 に示す様に、加速電圧が $3 \times 10^5 \text{ V} / \text{cm}$ 付近から、電流が流れ始めた。すなわち、エレクトライドC12A7化合物は、室温での電子放出材料として機能する事が分かった。なお、電流が流れ始める加速電圧は、試料の表面状態に依存する。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

図 1 は、実施例 1 における試料 1 ～ 4 の光吸収スペクトルを示すグラフである。

##### 【図 2】

図 2 は、実施例 1 における試料 5、6 の拡散反射スペクトルからクベルカームンク法により求めた光吸収スペクトルを示すグラフである。

##### 【図 3】

図 3 は、実施例 1 における試料 1 ～ 6 の電気伝導の温度変化を示すグラフである。

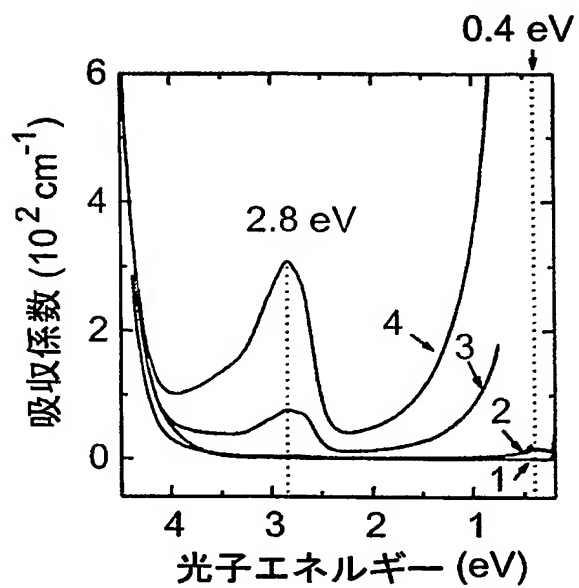
##### 【図 4】

図 4 は、実施例 1 により作成したエレクトライドC12A7化合物の加速電圧と電流の関係を示すグラフである。

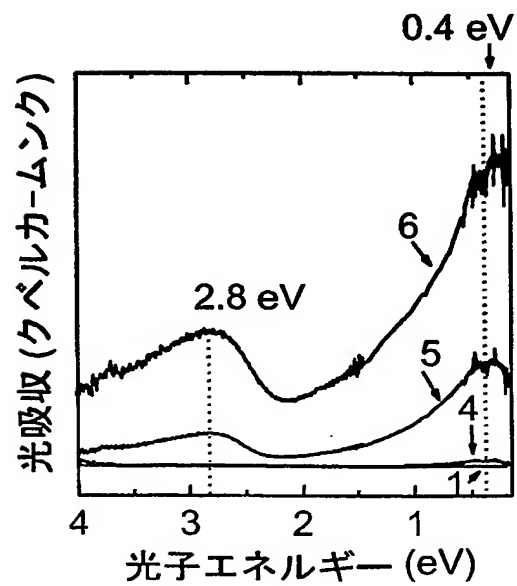
【書類名】

図面

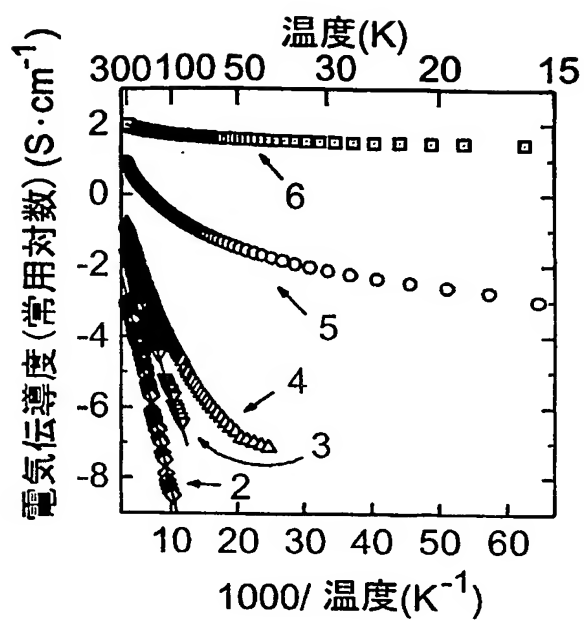
【図 1】



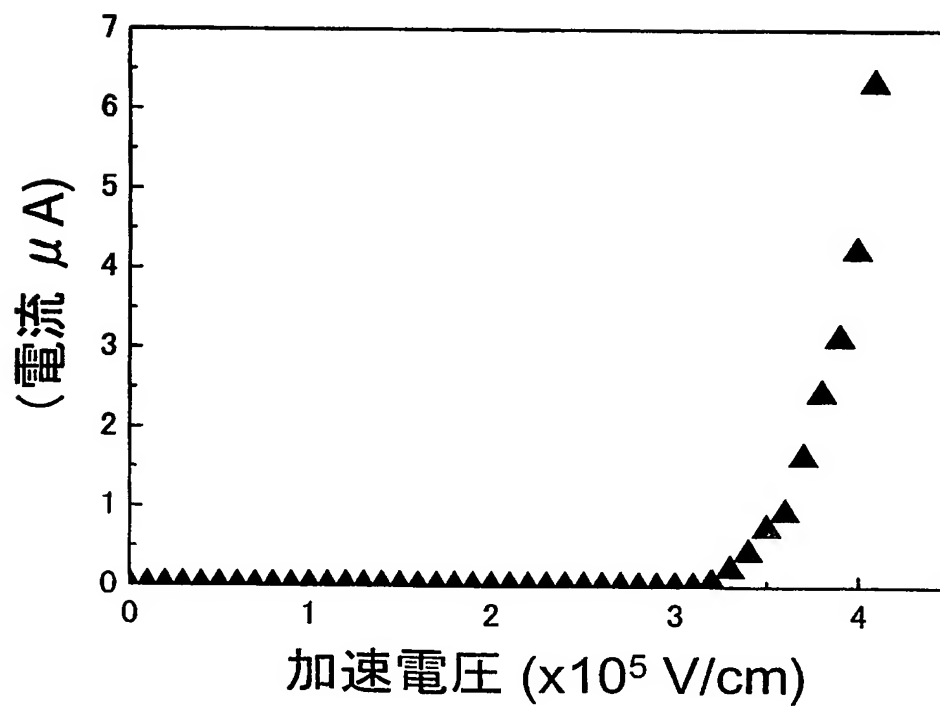
【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】  $\text{CaO}$ 又は $\text{SrO}$ と $\text{Al}_2\text{O}_3$ の固溶系において、室温で高い電気伝導性 ( $>10^{-4}\text{Scm}^{-1}$ ) を有する物質を得ることは困難であった。

【構成】  $12\text{CaO}\cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、 $12\text{SrO}\cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 化合物、又は $12\text{CaO}\cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ と $12\text{SrO}\cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ との混晶化合物に高濃度に電子を導入した化合物。フリー酸素をすべて電子で置換した該化合物は、 $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}(4\text{e}^-)$  又は、 $[\text{Sr}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}(4\text{e}^-)$  を陽イオン、電子を陰イオンとしたエレクトライド化合物とみなすことができる。単結晶や微粉末の静水圧プレス成形体をアルカリ金属又はアルカリ土類金属蒸気中で $700^\circ\text{C}$ 程度に保持するか、粉末の静水圧プレス成形体をカーボン坩堝中で $1600^\circ\text{C}$ 程度に保持し徐冷するか、 $600^\circ\text{C}$ 程度に保持した該化合物薄膜に希ガスイオンを打ち込むことによって、多くのフリー酸素を電子で置換できる。

【選択図】 図3



【書類名】 手続補正書

【整理番号】 E060P35

【提出日】 平成15年 7月 4日

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-183605

【補正をする者】

【識別番号】 396020800

【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

【代理人】

【識別番号】 100108671

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 義之

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

## 【補正の内容】

## 【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間 2 7 8 6 - 4 - 2 1 2

【氏名】 細野 秀雄

## 【発明者】

【住所又は居所】 東京都世田谷区松原 5 - 5 - 6

【氏名】 平野 正浩

## 【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区新城中町 6 - 2 0 カピトール川  
崎 I 4 0 8 号

【氏名】 林 克郎

## 【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市金沢区並木 1 - 1 1 - 2 - 2 0 1

【氏名】 宮川 仁

## 【発明者】

【住所又は居所】 山梨県甲府市宮前町 7 番地 山梨大学工学部附属クリス  
タル化学研究センター内

【氏名】 田中 功

【その他】 「田中」を「山中」と入力誤りをしました。

【プルーフの要否】 要

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-183605
受付番号	50301120640
書類名	手続補正書
担当官	神田 美恵 7397
作成日	平成15年 7月10日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【補正をする者】

## 【識別番号】

396020800

## 【住所又は居所】

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

## 【氏名又は名称】

科学技術振興事業団

## 【代理人】

申請人

## 【識別番号】

100108671

## 【住所又は居所】

神奈川県横浜市磯子区中原4-26-32-21  
1

## 【氏名又は名称】

西 義之

【書類名】 出願人名義変更届 (一般承継)  
【提出日】 平成15年10月31日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【事件の表示】  
【出願番号】 特願2003-183605  
【承継人】  
【識別番号】 503360115  
【住所又は居所】 埼玉県川口市本町四丁目 1 番 8 号  
【氏名又は名称】 独立行政法人科学技術振興機構  
【代表者】 沖村 憲樹  
【連絡先】 〒1 0 2 - 8 6 6 6 東京都千代田区四番町 5 - 3 独立行政法  
人科学技術振興機構 知的財産戦略室 佐々木吉正 TEL 0  
3 - 5 2 1 4 - 8 4 8 6 FAX 0 3 - 5 2 1 4 - 8 4 1 7  
【提出物件の目録】  
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1  
【援用の表示】 平成 1 5 年 1 0 月 3 1 日付提出の特第許 3 4 6 9 1 5 6 号にかか  
る一般承継による移転登録申請書に添付のものを援用する。  
【物件名】 登記簿謄本 1  
【援用の表示】 平成 1 5 年 1 0 月 3 1 日付提出の特第許 3 4 6 9 1 5 6 号にかか  
る一般承継による移転登録申請書に添付のものを援用する。

特願 2003-183605

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[396020800]

1. 変更年月日

1998年 2月24日

[変更理由]

名称変更

住 所

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

氏 名

科学技術振興事業団

特願 2 0 0 3 - 1 8 3 6 0 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 5 0 3 3 6 0 1 1 5 ]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 1 0 月 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号

氏 名

独立行政法人 科学技術振興機構

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ ~~FADED~~ TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ ~~GRAY~~ SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**